1 NPN prechod

jsou to dve diody ale nejsou \sim $Emitor Baze Kolektork dybychomne pripojili Bazitak bybyl NPN prechod zavreny proudbude prochazet protozev bazeneni zapornena bita – > proudem v jedne smyce – > ovlada me proudv druhe smycce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni <math>\beta = I_k/I_B$ uemitoruby vasipkan pripojili Bazitak bybyl NPN prechod zavreny proudbude prochazet protozev bazeneni zapornena bita – > proudem v jedne smyce – > ovlada me proudv druhe smycce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni $\beta = I_k/I_B$ uemitoruby v asipkan propositi produce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni $\beta = I_k/I_B$ uemitoruby v asipkan propositi produce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni $\beta = I_k/I_B$ uemitoruby v asipkan propositi produce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni $\beta = I_k/I_B$ uemitoruby v asipkan propositi produce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni $\beta = I_k/I_B$ uemitoruby v asipkan propositi produce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni produce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni produce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni produce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni produce v mensi smycemu zebyt prouddaleko slab si zesileni produce v mensi smycemu zebyt produce v mensi smycemu zeby

2 Bipolarni tranzistor

misto odsavani tak dodavam diry emitor a kolektor maji jine vlastnosti vstupni charakteristika baze-emitor - ξ chovase jak dioda vystupni pri U_{BE}

charakteristika je vazana proudem na Bazi kolektor a emitor musi byt dostatecne napeti z leva kolektor uprostred base a vpravo emitor jsou velice zavisle na teplotu jelikoz zacina se projevovat vodivost materialu kterou nechceme a zacneme se chovat jinak zesileni transitoru je velice zavisli na presnosti vyroby transitoru tranzistor jako spinac napeti na mezi basi a emitorem byt vetsi nez $0.5~\mathrm{V}$ a do saturace $0.7~\mathrm{tr}$